

# 有機ELテレビ用駆動素子

# 出光、処理能力40倍

新材料活用

## 科学技術

出光興産は次世代テレビとして期待される有機EL（エレクトロ・ルミネッセンス）ディスプレイ向けに、新材料を使った駆動素子を試作した。電子の速度が速くなるため、処理能力が現在のシリコン製の40倍以上、有機ELテレビで先行する韓国サムスン電子が採用を検討中の新素子と比べても4倍になる。高精細や低消費電力につながる。電機メーカーと組ん

で早期に実用化、材料のGO）系の半導体材料を事業展開を目指す。

試作したのは、酸化インジウム・ガリウム（IGZO）素子。独自の成膜技術を使い、ガリウムなどの配合量を調整、高品質な多結晶の薄膜を

ムなどの配合量を調整、高品質な多結晶の薄膜を

実現した。電子の速さの指標となる移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。

サムスン電子などは有機ELテレビ用のTFT素子に、東京工業大学の研究者が開発した酸化インジウム・ガリウム・亜

鉛（IGZO）の採用を指標とする移動度がアモルファス（非晶質）シリコンの40倍以上になることを確認した。